

**114 年度工研院南分院
雷射技術、積層製造技術及資訊與通訊技術等相關專利
讓與暨專屬授權案**

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強而有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與或專屬授權之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與/專屬授權標的：

（一）本案件包含專利 22 案 44 件（以下簡稱：「本案件標的」）。

（二）投標廠商得依實際需求，就「讓與模式」及/或「專屬授權模式」參與投標。惟本案件以「讓與模式」作為「本案件標的」之優先運用方式，若「讓與模式」有流標、廢標或無效投標者，始進行「專屬授權模式」之開標審議等程序；若「讓與模式」及「專屬授權模式」均流標、廢標、無效投標或未通過相關主管機關之核准者，工研院得另洽第三人為專屬授權或讓與等交易行為。

四、公開說明會與領標：

（一）公開說明會將於民國（下同）114 年 6 月 17 日 14 時舉辦。採取線上方式辦理。

（二）公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 114 年 6 月 16 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「114 年度工研院南分院雷射技術、積層製造技術及資訊與通訊技術等相關專利讓與暨專屬授權案-公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 114 年 6 月 16 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

（三）自本案件公告日起至截標日 114 年 6 月 25 日 17 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

- (一) 本案件採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同：
1. (密封) 價格封。
 2. 押標金。
 3. 公司設立證明文件(如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本)。
 4. 近兩年財報資料。(如新創公司成立未滿兩年，請檢附成立迄今之財報資料。)
 5. 公司基本資料暨運用規劃說明表。
 6. 商業營運計畫書一式 7 份。(若投標多案，廠商之商業營運計畫書得僅檢附一式 7 份，惟須於商業營運計畫書中敘明不同之標的運用規劃模式。)(前述全部資料文件等，以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「114 年度工研院南分院雷射技術、積層製造技術及資訊與通訊技術等相關專利讓與暨專屬授權案」，於截標日 114 年 6 月 25 日 17 時整(含)前(以送達收據為憑)掛號寄達或親送至：

31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

工研院技轉法律中心 葉小姐 收。

- (二) 廠商若有境外實施需求，請於公司基本資料暨運用規劃表及商業營運計畫書中詳細敘明，並於公司基本資料暨運用規劃表敘明境外實施金額。

- (三) 商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1. 公司背景／關係企業／合作夥伴簡介(20%)
2. 公司財務狀況(20%)
3. 公司營運／研發能力(20%)
4. 「本案件標的」運用規劃(30%)
5. 國內產業效益(10%)

(如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃等)

- (四) 投標方式：本案件採一案一標，即同一案專利不分開投標／開標。
(「本案件標的」以同一發明為一案。)

- (五) 本案件不得共同投標或就同一模式重複投標，但就不同模式(即「讓與模式」或「專屬授權模式」)得分別投標。

- (六) 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。

- (七) 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

- (一) 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。於決標當日依「八、決標方法」第(六)項約定加價後得標者，應於決標次日起 10 個工作日內補足押標金。若未於期限內補足者，工研院得沒收押標金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）。
- (二) 押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明收款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
- (三) 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於決標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

- (一) 投標時間截止後之投標。
- (二) 開標前業已公告停止本案件交易程序。
- (三) 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
- (四) 投標單附加任何成交條件者。
- (五) 「投標文件」之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
- (六) 「投標文件」有所缺漏者。但押標金不足或商業營運計畫書份數不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於複審前未能補足者，其投標為無效。
- (七) 投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果（包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果）轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及／或工研院同意者，不在此限。
- (八) 投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

八、決標方法：

- (一) 本案件以「讓與模式」作為「本案件標的」之優先運用方式，「讓與模式」於流標、廢標或無效投標後，始進行「專屬授權模式」之決標審議等程序；「讓與模式」之決標方式須通過初審（114 年 7 月 2 日）及複審（114 年 7 月 9 日）程序，「專屬授權模式」亦須經初審（114 年 7 月 2 日）及複審（114 年 7 月 9 日）程序，投標廠商於通過初審後，始能進入複審。工研院會另行通知通過初審之投標廠商依通知時間進行複審。
- (二) 得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。
- (三) 初審時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表、近兩年財報資料、商業營運計畫書、價格封等進行形式審查及確認。
- (四) 投標廠商通過初審者，由工研院開標審議委員會會議就商業營運計

畫書、價格等進行複審，投標廠商於複審時應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔等相關文件。

- (五) 投標廠商若有境外實施需求，除應依「五、投標方法」第(二)點敘明外，並應於複審時報告說明。
- (六) 複審時，工研院開標審議委員會議將同時開啟超過及格分之所有投標廠商價格封，將以投標金額最高且高於底價者得標。若有二(含)家以上投標廠商出價且皆無超過底價，則出價金額最高之廠商有一次優先加價機會，若此優先加價仍無超過底價，之後則由超過及格分之所有投標廠商同時議價，議價次數以三次為限，由金額最高且高於底價者得標。若有二(含)家以上超過及格分之投標廠商之投標金額超過底價且相同，得提供該投標廠商議價機會，並以高價者得標。議價次數以三次為限，經三次議價後之投標金額仍相同者，由工研院現場抽籤決定之。(議價時，若非投標廠商負責人出席，須填妥並提供委託代理授權書)
- (七) 開標時將請律師到場監標。
- (八) 開標結果依政府法令相關規定，須向主管機關呈報者，則於主管機關同意後始生效力。
- (九) 工研院將個別通知投標廠商開標結果(不公告得標廠商)。
- (十) 對於「讓與模式」及「專屬授權模式」均流標、廢標或無效投標之「本案件標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。

九、契約事項：

- (一) 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作日內，與工研院簽訂「讓與契約書」/「專屬授權契約書」。「讓與契約書」/「專屬授權契約書」原則上應具備「九、契約事項」所載之條件；但基於產業運用效益等考量，雙方得於「讓與契約書」/「專屬授權契約書」中另議合法合規之條件，工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」/「專屬授權契約書」與否之權利。
- (二) 得標廠商如無正當理由屆期末與工研院簽訂「讓與契約書」/「專屬授權契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格(但經工研院同意者，不在此限)；此外，工研院得另洽第三人為專屬授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。
- (三) 得標廠商與簽訂「讓與契約書」/「專屬授權契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。

- (四) 遵守政府法令規定：得標廠商就「本案件標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、國家安全法、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定）。前述法令變動時，亦同。
- (五) 得標廠商應支付工研院讓與/專屬授權費用，讓與/專屬授權費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
- (六) 得標廠商簽署「讓與契約書」/「專屬授權契約書」且生效時，本案件簽約保證金移充為之讓與/專屬授權費用。「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效，得標廠商充分了解「本案件標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。「專屬授權契約書」自其所載生效日起生效，「授權標的」之授權期間自「專屬授權契約書」生效日起 10 年，惟專利有效期間早於前述期間者，該專利授權期間則以其專利有效期間為準。
- (七) 反授權約定：得標廠商同意經濟部及工研院就「本案件標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予經濟部及/或工研院。得標廠商嗣後若將「本案件標的」全部或一部專屬授權或讓與第三人（以下簡稱「後手」）時，並應使「後手」同意本條約定。「後手」再為專屬授權或讓與時亦同。
- (八) 得標廠商應就「本案件標的」之一部或全部，容忍於「讓與契約書」/「專屬授權契約書」生效前：
1. 工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；
 2. 工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；
 3. 工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。
- (九) 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」/「專屬授權契約書」僅為工研院同意讓與/專屬授權「本案件標的」予得標廠商。工研院亦僅依本案件公告日之「本案件標的」現狀讓與/專屬授權得標廠商，工研院不擔保「本案件標的」之已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「本案件標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「本案件標的」所製造產品之產品責任。「本案件標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「本案件標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」/「專屬授權契約書」

生效後，「本案件標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「本案件標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「本案件標的」之諮詢講解或訓練之義務。

- (十) 「本案件標的」之讓與/專屬授權登記手續全權由工研院依工研院作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與/專屬授權登記手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」/「專屬授權契約書」生效之日起負擔「本案件標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「本案件標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
- (十一) 「本案件標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之政府法令規定，配合工研院向主管機關（包含但不限於經濟部產業技術司，下同）為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院，且應依工研院要求提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及／或主管機關核准及同意後始得為之：
1. 得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；
 2. 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；
 3. 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；
 4. 得標廠商讓與「本案件標的」之對象非我國研究機構或企業者。
- (十二) 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」/「專屬授權契約書」，並得將「本案件標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「本案件標的」收歸國有：
1. 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「本案件標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
 2. 得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「本案件標的」者。
 3. 為增進國家重大利益者。
- 有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返

還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。

- (十三) 得標廠商如將「本案件標的」之全部或一部授權或讓與「後手」時，應依政府相關法令及「讓與契約書」/「專屬授權契約書」約定，取得主管機關及／或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。
- (十四) 若得標廠商違反「九、契約事項」任一條款或讓與、專屬授權、輾轉讓與或專屬授權「本案件標的」予非專利實施實體（Non-Practicing Entity，以下簡稱「NPE」），或未經工研院及／或經濟部同意之受讓者（以下簡稱「未經同意之受讓者」），造成第三人遭受侵權警告或涉訟時，工研院有權逕行將「本案件標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」/「專屬授權契約書」生效日起實施，並保有相關之收益，且已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。得標廠商應將本約定載明於與「後手」之讓與契約，否則即視為得標廠商已將「本案件標的」讓與予「NPE」或「未經同意之受讓者」，工研院得依前述約定行使相關權利。
- (十五) 得標廠商應使所有「後手」遵守「九、契約事項」第七項至第九項、第十一項至第十七項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。
- (十六) 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「本案件標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院並取得書面同意。得標廠商於「讓與契約書」/「專屬授權契約書」生效後對第三人就「本案件標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。
- (十七) 得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」/「專屬授權契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後30日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」/「專屬授權契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體

產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」/「專屬授權契約書」或以書面另議新約。

- (十八) 得標廠商應盡力進行產品開發等運用「本案件標的」工作，若得標廠商未能舉證於合理期間內有運用「本案件標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」/「專屬授權契約書」或將「本案件標的」非專屬授權第三人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本案件公告為「讓與契約書」/「專屬授權契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本案件公告、「本案件標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或抵觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本案件公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心 葉小姐。

電話：(03) 591-3751，傳真：(03) 582-0466。

電子信箱：jlyeh@itri.org.tw。

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

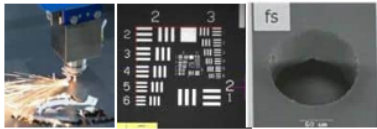
附件一：本案件標的簡介

(歡迎產業界針對有興趣之標的報名公開說明會了解相關資訊。)

12案23件

標的技術說明-雷射技術

- 雷射高功率、超短脈衝與智慧控制等技術推陳出新，但全球雷射加工業主要仍以高精度製造技術為主。
- 可應用於光電/半導體雷射加工、雷射光源光學系統、面板與綠能產業等領域，即使現在已有彩色列印與雷射貼合先進技術，但特定市場仍需要雷射製程與雷射光路調控技術。
- 本專利組合技術涵蓋完整、應用廣泛，且包含台灣、美國、中國和德國等國別，布局完整。
- 主要優勢為導入雷射加工智慧化、系統化、軟體整合，達成生產速度以及製成品質提升。



雷射加工關鍵模組技術

<6案13件>

雷射加工裝置與環形流道提升大孔徑鑽孔速率，大面積雷射加工排屑，同軸視覺影像技術降低定位誤差與影像誤差。

P27000035 TWI438050 CN103157909 雷射(激光)加工誤差校正方法及處理器	P27040011 TWI599431 US10213873 CN106624392 雷射(激光)加工裝置及雷射排屑裝置	P27030015 (TW/CN/DE) 三維雷射(激光)加工裝置及定位誤差校正方法	P70050001 (TW) 雷射加工裝置及雷射加工排屑裝置	P70050002 (TW/US/CN) 雷射(激光)均勻加工裝置及其方法	P70060006 (TW) 撕膜裝置
--	---	---	---	--	----------------------------------

光學技術

<4案7件>

光學技術光束擴散模組以及光束產生系統降低被照射面產生散斑導致照射不均，雷射掃描裝置可補償可見光光束經掃描聚焦單元造成像差與色散。

P27020020 (TW/US) 光束擴散模組以及光束產生系統	P27960065 TWI835252 一種雷射校正片及雷射校正系統	P27990028 (TW/US/CN) 雷射(激光)掃描裝置	P27000049 (TW) 可變景深之光學系統與調制方法及其光學加工方法
--	---	---	---

電學技術

<2案3件>

即時調變輸出雷射脈波觸發裝置及方法，以低能量與高能量交互進行預熱與加工。

P27020022 (TW) 導電線路的形成方法	P27960064 (TW/US) 程式化雷射觸發裝置及其控制方法
------------------------------------	---

雷射技術-特色專利

專利亮點

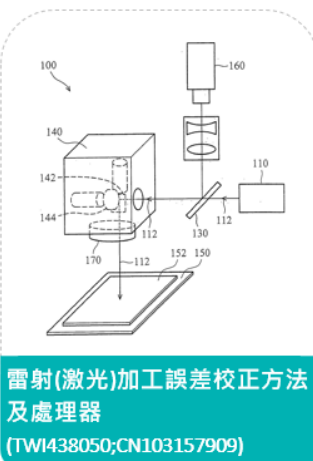
- 自動建立「視覺取像位置補償表」與「雷射加工位置補償表」，實現加工位置的即時補正，**減少人工調整需求**。
- 「視覺畸變誤差」與「雷射/視覺光程誤差」的分離校正機制，有效**提升雷射加工精度**。
- 提出一組整合至加工系統中的誤差校正處理器模組，包含圖像辨識、誤差計算與補償功能，**可直接應用於商用雷射加工設備**。

專利效益

- 利用同軸視覺影像技術來分離畸變誤差與雷射/視覺光程誤差，**降低人為調整與測試成本**，達快速校正的目的。
- 自動試加工與補償步驟設計，**有效縮短校正與量產時間**。

產業機會與需求

- 高精度製程自動化浪潮下，如半導體、面板與綠能產業等，對微米等級加工精度的要求日益嚴格。
- 可提供作為既有雷射機升級套件，提高其加工良率與競爭力。

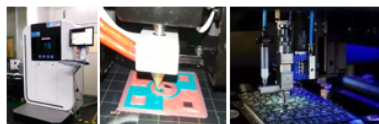


◆ 曾非專屬授權

7案16件

標的技術說明-積層製造技術

- 積層製造技術智能列印、高速列印等技術推陳出新，但全球航太、模具及生醫製造業主要仍以傳統列印技術為主。
- 可應用於金屬/非金屬積層製造、運動鞋服裝軟性材料圖案標籤等領域，即使現在已有更先進積層製造前製程及製程控制軟體技術，但特定市場仍需要積層製造製程及控制技術。
- 本專利組合技術涵蓋完整、應用廣泛，且包含台灣、美國、中國等國別，布局完整。
- 搭配智慧機器、加減法製程整合等，引領產業走向智慧化可量產技術發展，維持積層製造的產業優勢。



製程技術(金屬)

<1案1件>

在模型上重複塗佈及加熱形成積層結構，以形成三維物件的方法。

P27040037(TW)

積層製造方法

系統技術(金屬)

<1案3件>

可裝載不同種類粉體的鋪層裝置及其列印方法。

P27000091

TWI472427/US9533350 / US10675655

粉體鋪層裝置與方法及其積層製造方法

噴頭技術(非金屬)

<1案3件>

FDM製造可變孔口裝置。

P70050014(TW/CN)

三維列印(打印)供料裝置與可變孔口裝置/可變孔口裝置

應用領域

<4案9件>

異質多層材料製作方法及其椎間融合器應用 / 電池電極結構及其雷射導電粉體燒結製作方法 / 具肘腕關節機構的義肢/可擴張方式將韌帶固定的裝置。

P27030024

TWI548429

US10463500

醫療用複合材料及其製作方法與應用

P70050005(TW/US/CN)

電池電極結構及其製作方法

P70060014(TW/US/CN)

義肢(假肢)

P70070011(TW)

可擴張之韌帶固定裝置

積層製造技術-特色專利

專利亮點

- 利用盛料容器的轉動運動混合與傾倒粉體，再透過線性位移運動將粉體均勻鋪層，**大幅提升鋪粉精度與均勻性**。
- 盛料容器內建加熱元件，可對粉體進行混合預熱處理，有效**減少雷射加工後的熱應力、變形與裂痕**。
- 鋪層過程中，盛料容器外圍具備提供下壓分力的功能，提升粉體鋪層密度，進而**提升成品機械強度與品質**。

專利效益

- 減少因溫差導致的熱變形與內部應力，增加製件密度與均勻性，**改善表面粗糙度與機械性能**。
- 透過預熱與分層加工可生產多材質、多階段結構，**擴展產品應用範圍**。

產業機會與需求

- 隨著金屬與高性能聚合物3D列印廣泛應用，本專利可用於製作高精度、複雜結構或客製化部件，如航太、汽車、醫療器材等。
- 預熱與壓實設計可降低成形過程中因粉末不均或冷熱變形導致的失敗率。

粉體鋪層裝置與方法及其積層製造方法

(TWI472427/US9533350/
US10675655)

◆ 曾非專屬授權予三家廠商

◆ 台灣、美國專利被89件專利引用

3案5件

標的技術說明-資訊與通訊技術

- TWI645698、US10742783與TWI673613專利皆基於國際的通訊標準OPC UA，在製造業的智慧聯網技術、數據服務的應用上，可透過資料編解碼的方式，降低數據量，提升傳輸速度。本專利組合包含台灣、美國等國別。
- 可應用於網路管理、網路社群、人機互動以及居家健康照護等領域，提供相關產業終端產品專利保護，並降低開發風險。
- 有助於智慧家庭相關產業在人機介面、健康照護以及社群服務等網路設備提供競爭優勢。



網路與通訊處理

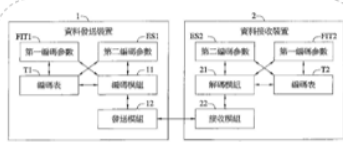
<3案5件>

網路資源管理、資訊安全、事件通報、社交關聯。

P27030008(TW/US)
週期性封包管理方法

P52060011
TWI645698
US10742783
資料發送裝置、資料接收裝置及其方法/具有編碼或解碼功能的資料發送裝置、資料接收裝置及其方法

P52070025
TWI673613
伺服器及其資源調控方法



資料發送裝置、資料接收裝置及其方法/具有編碼或解碼功能的資料發送裝置、資料接收裝置及其方法

◆ 曾非專屬授權予兩家廠商

特色專利 亮點與效益

1. 因應工業4.0導入智慧整合感控系統及連結物聯網與服務聯網，藉以形成「智慧製造+服務」的全新商業模式。
2. 面對與日俱增的連網設備，在有限的傳輸網路頻寬之下，提升工業網路傳輸效率，降低網路傳輸的封包數量與負載。



附件二：專利清單

(一) 雷射技術：12 案 23 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	授權紀錄
1	1	P27000035CN	激光加工誤差校正方法及處理器	中國大陸	獲證	CN103157909	20160120	20311226	經濟部產業技術司	工研院	
	2	P27000035TW	雷射加工誤差校正方法及處理器	中華民國	獲證	TWI438050	20140521	20311215	經濟部產業技術司	工研院	v
2	3	P27030015CN	三維激光加工裝置及定位誤差校正方法	中國大陸	獲證	CN105834580	20171205	20350115	經濟部產業技術司	工研院	
	4	P27030015DE	三維雷射加工裝置及定位誤差校正方法	德國	獲證	EP3045256	20190417	20351109	經濟部產業技術司	工研院	
	5	P27030015TW	三維雷射加工裝置及定位誤差校正方法	中華民國	獲證	TWI577484	20170411	20341119	經濟部產業技術司	工研院	v
3	6	P27040011CN	激光加工裝置及激光排屑裝置	中國大陸	獲證	CN106624392	20181002	20360117	經濟部產業技術司	工研院	
	7	P27040011TW	雷射加工裝置及雷射排屑裝置	中華民國	獲證	TWI599431	20170921	20351102	經濟部產業技術司	工研院	v
	8	P27040011US	雷射加工裝置及雷射排屑裝置	美國	獲證	US10213873	20190226	20360701	經濟部產業技術司	工研院	
4	9	P70050001TW	雷射加工裝置及雷射加工排屑裝置	中華民國	獲證	TWI613028	20180201	20360908	經濟部產業技術司	工研院	v
5	10	P70050002CN	激光均勻加工裝置及其方法	中國大陸	獲證	CN107914080	20200529	20361109	經濟部產業技術司	工研院	
	11	P70050002TW	雷射均勻加工裝置及其方法	中華民國	獲證	TWI604907	20171111	20361010	經濟部產業技術司	工研院	v
	12	P70050002US	雷射均勻加工裝置及其方法	美國	獲證	US10705346	20200707	20380412	經濟部產業技術司	工研院	
6	13	P70060006TW	撕膜裝置	中華民國	獲證	TWI664135	20190701	20380102	經濟部產業技術司	工研院	
7	14	P27000049TW	可變景深之光學系統與調制方法及其光學加工方法	中華民國	獲證	TWI454331	20141001	20311114	經濟部產業技術司	工研院	v
8	15	P27020020TW	光束擴散模組以及光束產生系統	中華民國	獲證	TWI529020	20160411	20331201	經濟部產業技術司	工研院	v
	16	P27020020US	光束擴散模組以及光束產生系統	美國	獲證	US9353929	20160531	20350205	經濟部產業技術司	工研院	v
9	17	P27960065TW	一種雷射校正片及雷射校正系統	中華民國	獲證	TWI335252	20110101	20271129	經濟部產業技術司	工研院	v
10	18	P27990028CN	激光掃描裝置	中國大陸	獲證	CN102547048	20150325	20311020	經濟部產業技術司	工研院	
	19	P27990028TWC1	雷射掃描裝置	中華民國	獲證	TWI428194	20140301	20311018	經濟部產業技術司	工研院	v
	20	P27990028USC1	雷射掃描裝置	美國	獲證	US8669507	20140311	20310722	經濟部產業技術司	工研院	
11	21	P27020022TW	導電線路的形成方法	中華民國	獲證	TWI481327	20150411	20331030	經濟部產業技術司	工研院	
12	22	P27960064TW	可程式化雷射觸發裝置及其控制方法	中華民國	獲證	TWI330563	20100921	20271127	經濟部產業技術司	工研院	v
	23	P27960064US	可程式化雷射觸發裝置及其控制方法	美國	獲證	US9350136	20160524	20320715	經濟部產業技術司	工研院	



(二) 積層製造技術：7 案 16 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	授權紀錄
13	24	P27040037TW	積層製造方法	中華民國	獲證	TWI601629	20171011	20360411	經濟部產業技術司	工研院	
14	25	P27000091TW	粉體鋪層裝置與方法及其積層製造方法	中華民國	獲證	TWI472427	20150211	20320119	經濟部產業技術司	工研院	V
	26	P27000091US	粉體鋪層裝置與方法及其積層製造方法	美國	獲證	US9533350	20170103	20340812	經濟部產業技術司	工研院	V
	27	P27000091USD 1	粉體鋪層裝置與方法及其積層製造方法	美國	獲證	US10675655	20200609	20330306	經濟部產業技術司	工研院	
15	28	P70050014CN	三維打印供料裝置與可變孔口裝置	中國大陸	獲證	CN108145964	20201030	20370103	經濟部產業技術司	工研院	
	29	P70050014TW	三維列印供料裝置與可變孔口裝置	中華民國	獲證	TWI602765	20171021	20361201	經濟部產業技術司	工研院	
	30	P70050014TWD 1	可變孔口裝置	中華民國	獲證	TWI654070	20190321	20361201	經濟部產業技術司	工研院	
16	31	P27030024TW	醫療用複合材料及其製作方法與應用	中華民國	獲證	TWI548429	20160911	20341106	經濟部產業技術司	工研院	V
	32	P27030024US	醫療用複合材料及其製作方法與應用	美國	獲證	US10463500	20191105	20360412	經濟部產業技術司	工研院	V
17	33	P70050005CN	電池電極結構及其製作方法	中國大陸	獲證	CN108110219	20200717	20370105	經濟部產業技術司	工研院	
	34	P70050005TW	電池電極結構及其製作方法	中華民國	獲證	TWI617073	20180301	20361124	經濟部產業技術司	工研院	V
	35	P70050005US	電池電極結構及其製作方法	美國	獲證	US10644305	20200505	20380530	經濟部產業技術司	工研院	
18	36	P70060014CN	假肢	中國大陸	獲證	CN109893306	20210629	20380926	經濟部產業技術司	工研院	
	37	P70060014TW	義肢	中華民國	獲證	TWI643606	20181211	20371207	經濟部產業技術司	工研院	
	38	P70060014US	義肢	美國	獲證	US10433985	20191008	20380503	經濟部產業技術司	工研院	
19	39	P70070011TW	可擴張之韌帶固定裝置	中華民國	獲證	TWI689296	20200401	20381206	經濟部產業技術司	工研院	

(三) 資訊與通訊技術：3 案 5 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	授權紀錄
20	40	P27030008TW	週期性封包管理方法	中華民國	獲證	TWI551088	20160921	20341125	經濟部產業技術司	工研院	
	41	P27030008US	週期性封包管理方法	美國	獲證	US9693283	20170627	20351026	經濟部產業技術司	工研院	
21	42	P52060011TW	資料發送裝置、資料接收裝置及其方法	中華民國	獲證	TWI645698	20181221	20370716	經濟部產業技術司	工研院	V
	43	P52060011US	具有編碼或解碼功能的資料發送裝置、資料接收裝置及其方法	美國	獲證	US10742783	20200811	20380101	經濟部產業技術司	工研院	
22	44	P52070025TW	伺服器及其資源調控方法	中華民國	獲證	TWI673613	20191001	20381016	經濟部產業技術司	工研院	V